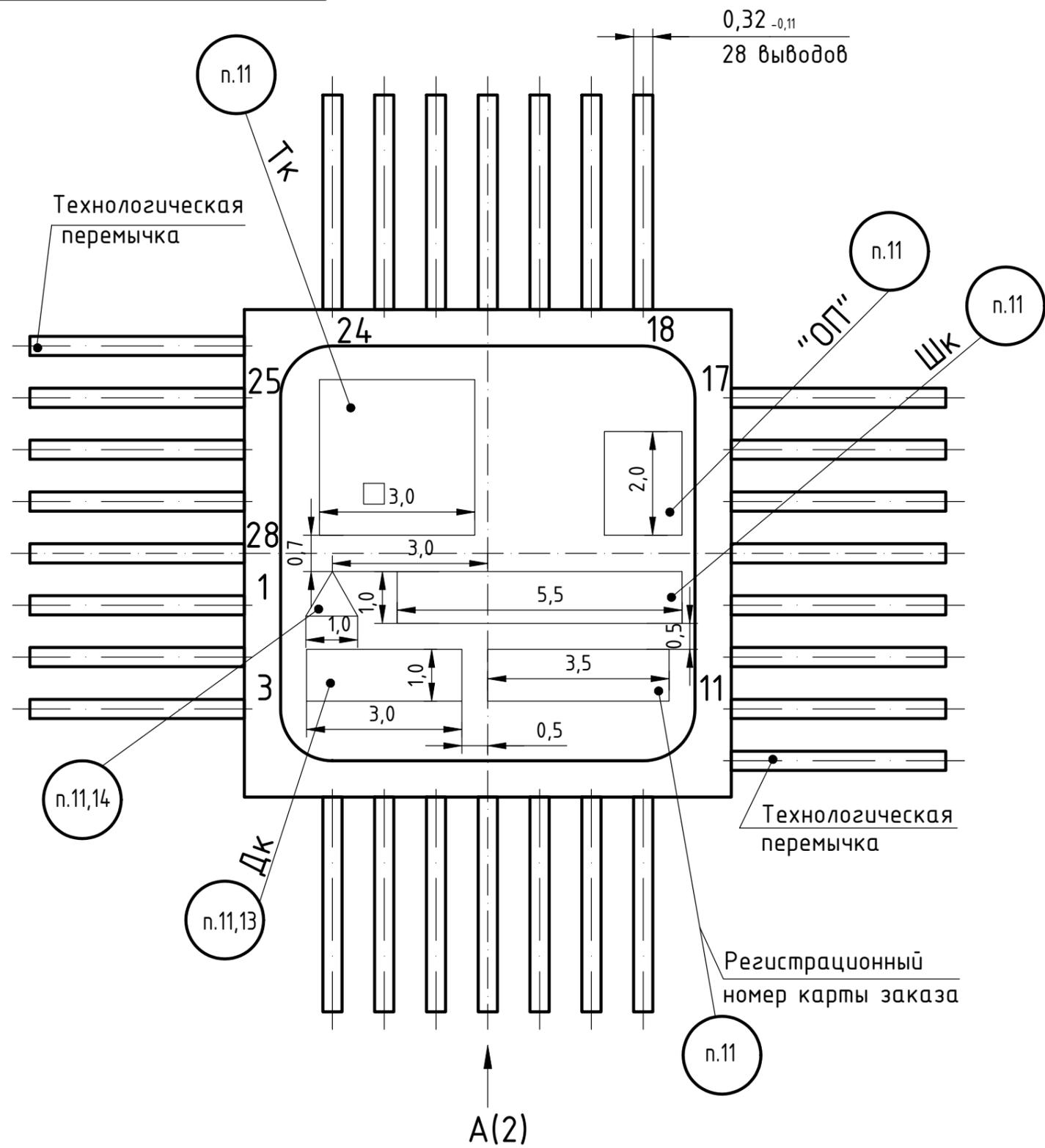


Г АВЛ.431260.018СБ

Перв. примен. Г АВЛ.431260.018  
Справ. №  
Подп. и дата  
Взам. инв. № Инв. № дубл  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

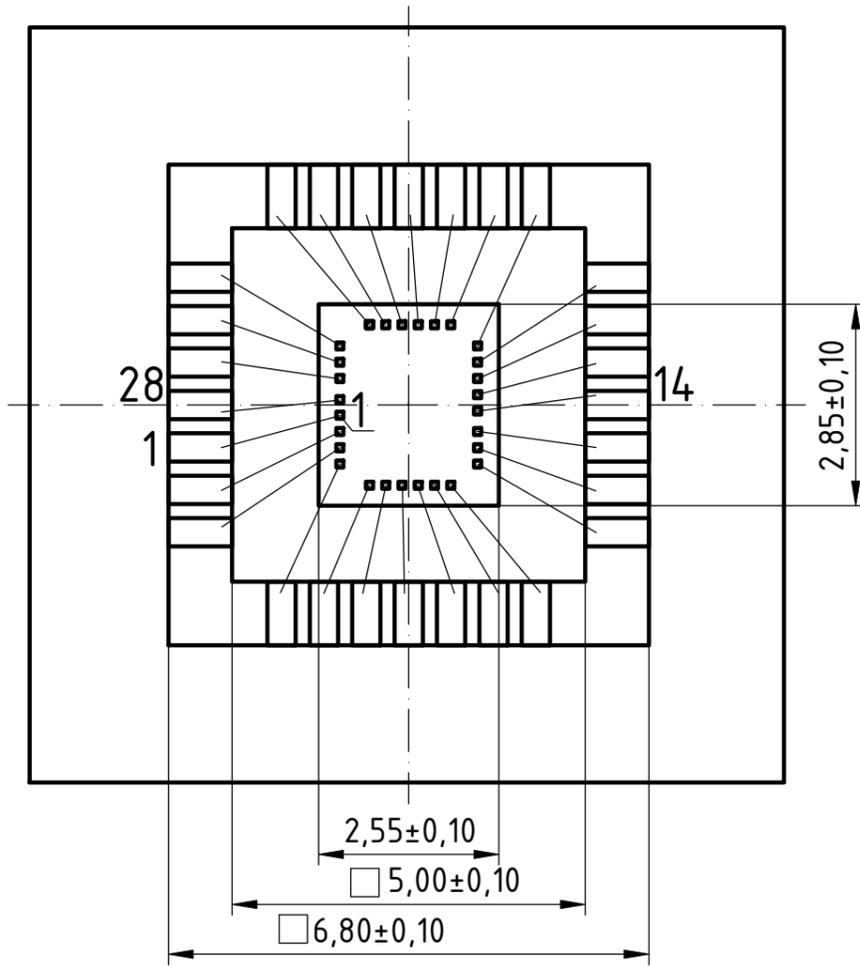


1. Размеры для справок.
2. \*Размеры после покрытия.
3. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
4. Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
5. Смещение плоскостей симметрии выводов от номинального расположения в зоне Ж не более 0,125мм (допуск зависимый).
6. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Д - максимальная стрела прогиба проводника.
7. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки по РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах, указанных в описании образцов внешнего вида ДК0.347.273Д2, и наплыв металла в зоне Е по контуру крышки.
8. Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен быть не более  $6,65 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{см}^3/\text{с}$ .
9. Обрубку выводной рамки производить после герметизации корпуса в размер К. При этом допускается отсутствие покрытия на торцевой части выводов в местах обрубki, наличие заусенцев не более 0,1 мм.
10. Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида ДК0.347.273Д2.
11. Маркировать составом маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 Дк, Шк, Нк, ОП, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,5 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, знак Δ согласно основному виду.
12. С обратной стороны маркировать согласно виду В.
13. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
14. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
15. В зоне Шк маркировать обозначение изделия "Н5503ХМ1".
16. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.
17. Допускается нанесение клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
18. Нумерация выводов приведена условно.
19. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки Г АВЛ.431260.018ЭТ.

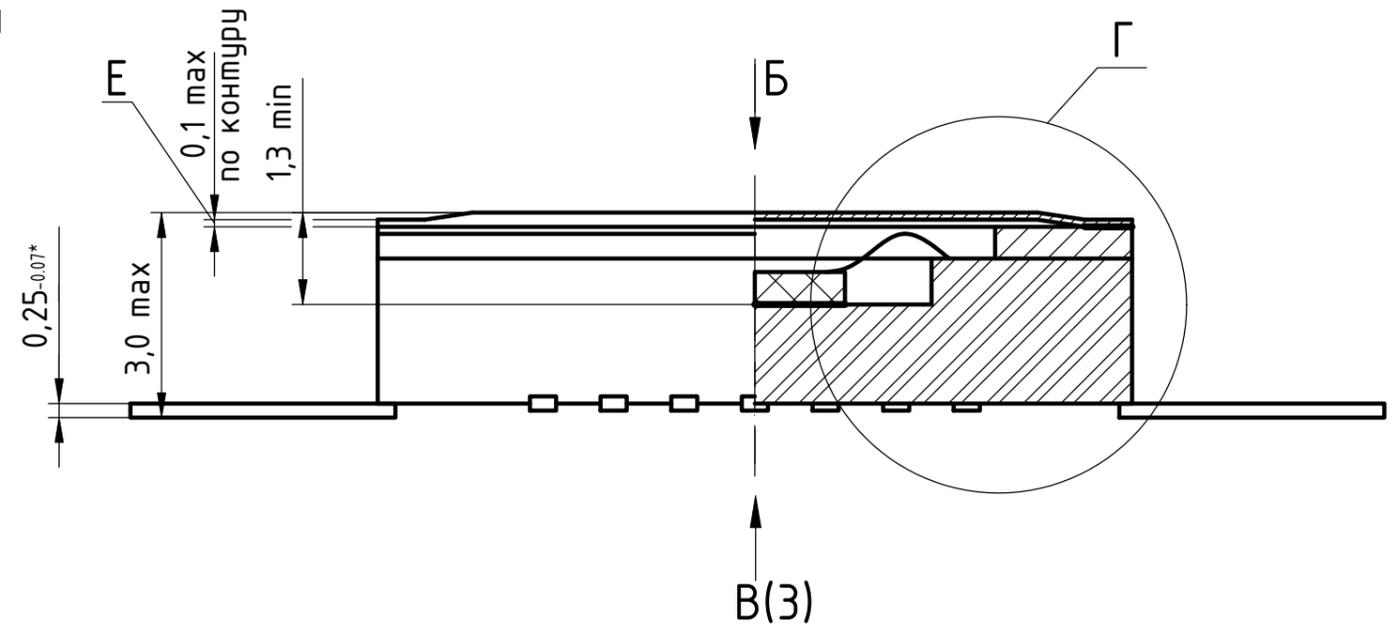
					<b>Г АВЛ.431260.018СБ</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Микросхема интегральная Н5503ХМ1 Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Астахова					А	1,5г.	10:1
Пров.	Тукашкин					Лист 1		Листов 3
Т.контр.	Терпигорева							
Н.контр.	Васильев							
Утв.	Денисов							

Б

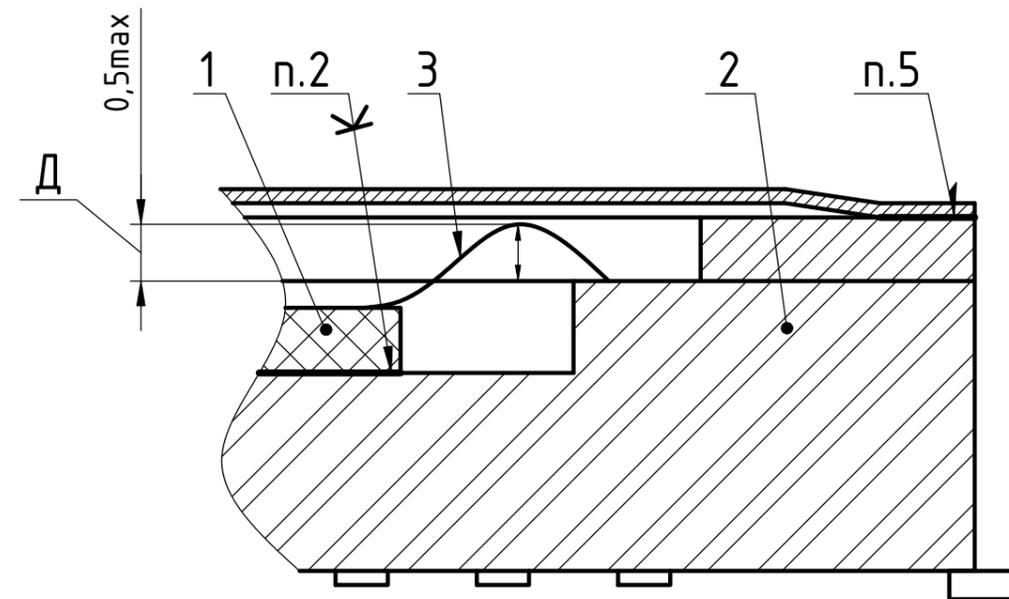
Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны



A(1)

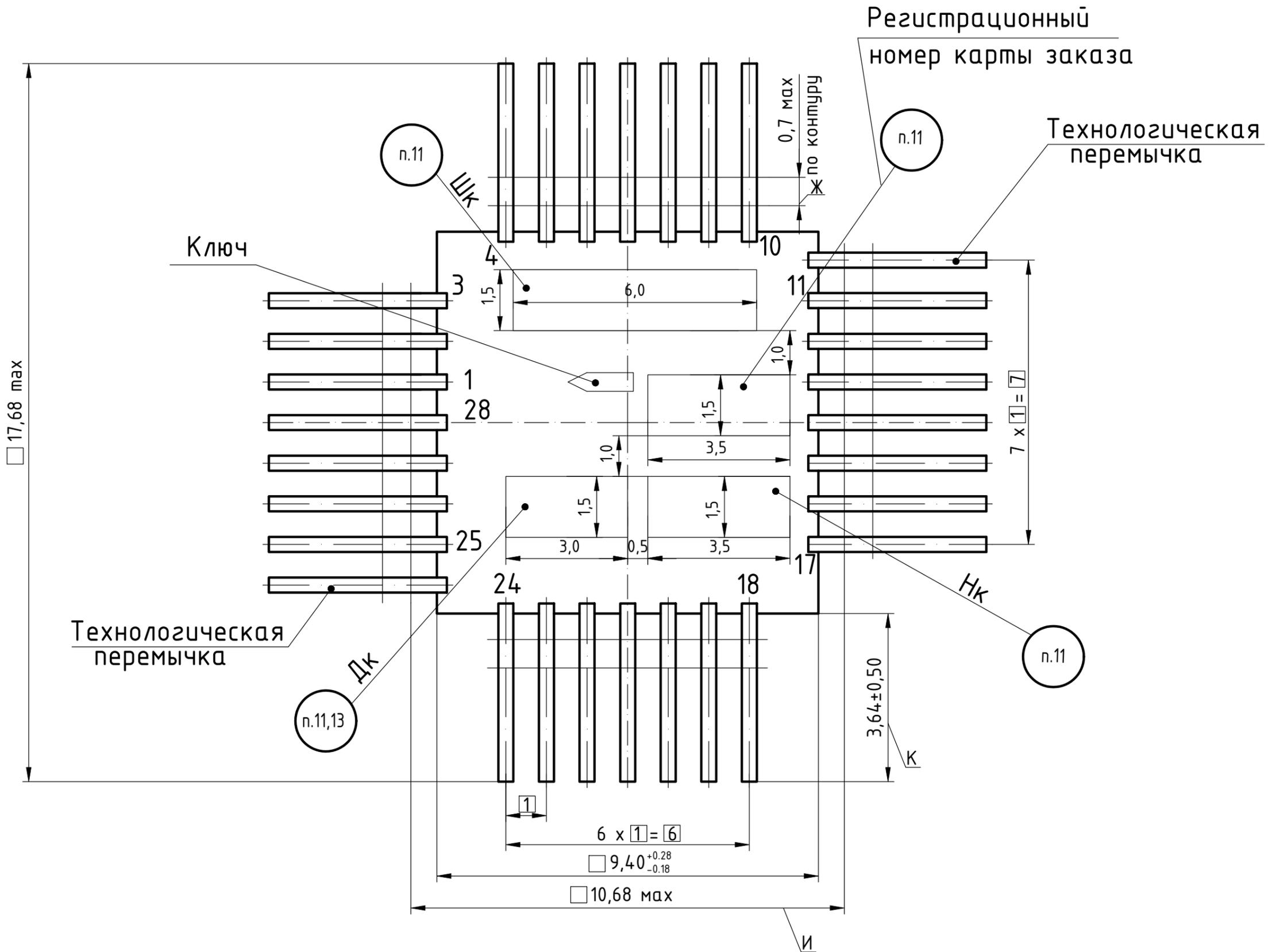


Г(20:1)



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

В(2)



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата